








	<h2 style="color: red;">SI5856DC-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI5856DC-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 4.4A 1206-8
	Datenblätter:  SI5856DC-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 21998 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5856DC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 4.4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21998 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 4.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5856DC-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 4.4A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Ta)

SI5856DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5856DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5856DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI5856DC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5856DC-T1-GE3 VB SI5856DC-T1-GE3 VB</p>	 <p>SI5855DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.7A 1206-8</p>	 <p>SI5855DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.7A 1206-8</p>	 <p>SI5857DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>
 <p>SI5856DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5857DU-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5856DC Vishay SI5856DC Vishay</p>	 <p>SI5855DC-T1-GE3 VISHAY VISHAY 1206-8</p>

SI5856DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5856DC-T1-E3 Datenblatt	SI5856DC-T1-E3-Datenblätter	SI5856DC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5856DC-T1-E3
SI5856DC-T1-E3 Electronic	SI5856DC-T1-E3-Komponenten	SI5856DC-T1-E3-Verteiler	SI5856DC-T1-E3-Bild	SI5856DC-T1-E3 Aktie	SI5856DC-T1-E3 Teil
SI5856DC-T1-E3 Preis	SI5856DC-T1-E3 Hersteller	SI5856DC-T1-E3 Bild	SI5856DC-T1-E3 RFQ	SI5856DC-T1-E3 Inventar	SI5856DC-T1-E3 Online bestellen
SI5856DC-T1-E3 Neu	SI5856DC-T1-E3 Original	SI5856DC-T1-E3 garantiert			

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited